

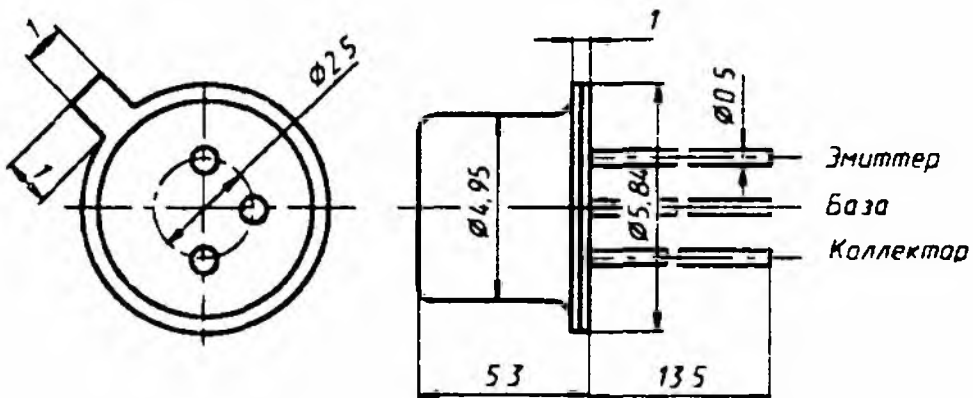
КТ349А, КТ349Б, КТ349В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры $p-n-p$ универсальные. Предназначены для применения в усилителях сигналов высокой частоты и переключающих устройствах. Выпускаются в металлоглазном и в пластмассовых корпусах с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 0,5 г.

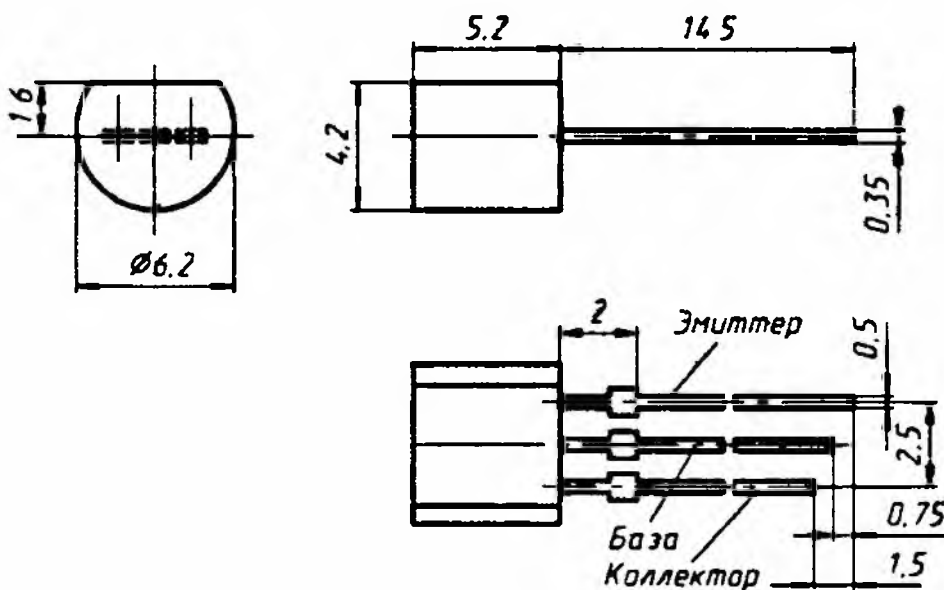
КТ349(А-В)

Вариант 1



КТ349(А-В)

Вариант 2



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ при $U_{кБ} = 1$ В, $I_3 = 10$ мА:

$T = +25$ °С:

КТ349А	20...80
КТ349Б.....	40...160
КТ349В.....	120...300

$T = -40$ °С, не менее:

КТ349А	10
КТ349Б.....	20
КТ349В.....	60

$T = +85$ °С.

КТ349А	18...160
КТ349Б.....	36...320
КТ349В.....	108...600

Граничная частота коэффициента передачи
тока при $U_{кБ} = 5$ В, $I_3 = 10$ мА, не менее..... 300 МГц

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер
при $I_k = 10$ мА, $I_б = 1$ мА, не более 0,3 В

Напряжение насыщения база—эмиттер
при $I_k = 10$ мА, $I_б = 1$ мА, не более 1,2 В

Обратный ток коллектора при $U_{кБ} = 10$ В,
не более:

$T = +25$ °С	1 мкА
$T = +85$ °С	6 мкА

Обратный ток коллектор—эмиттер
при $U_{кЭ} = 15$ В, $R_{бЭ} \leq 10$ кОм, не более 1,5 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{зБ} = 4$ В,
не более 1 мкА

Емкость коллекторного перехода
при $U_{кБ} = 5$ В, не более 6 пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{зБ} = 0$,
не более 8 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база..... 20 В

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер
при $R_{бЭ} \leq 10$ кОм 15 В

Постоянное напряжение база—эмиттер..... 4 В

Импульсный ток коллектора при $t_{и} \leq 1$ мс..... 40 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при $T \leq +30 \text{ }^\circ\text{C}$	200 мВт
при $T = +85 \text{ }^\circ\text{C}$	108 мВт
Тепловое сопротивление переход—среда.....	0,6 $^\circ\text{C}/\text{мВт}$
Температура <i>p-n</i> перехода	+150 $^\circ\text{C}$
Температура окружающей среды	-40...+85 $^\circ\text{C}$